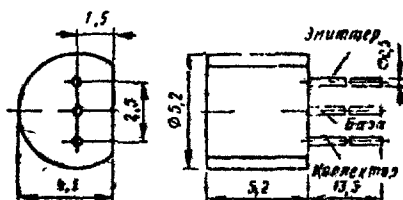


KT375A, KT375B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры для универсальных. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,25 г.

KT375(A, B)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB}=2$ В, $I_B=20$ мА.

$T=+25^\circ\text{C}$

KT375A

KT375B

10 100

50 280

$T=-45^\circ\text{C}$

KT375A

KT375B

8...100

25...280

$T=+85^\circ\text{C}$

KT375A

KT375B

10 200

50 560

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{KB}=10$ В, $I_K=5$ мА, не менее

250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB}=10$ В, $I_B=5$ мА, не более

300 нс

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=10$ мА, $I_B=1$ мА, не более

0,4 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=10$ мА, $I_B=1$ мА, не более

1 В

Обратный ток коллектора при $U_{KB}=U_{KB\text{ макс}}$, не более:

$T=+25^\circ\text{C}$

$T=+85^\circ\text{C}$

1 мкА

10 мкА

1 мкА

5 пФ

20 пФ

Обратный ток эмиттера при $U_{EB}=5$ В, не более

Максимальная мощность перехода при $U_{KB}=10$ В, не более

Максимальная мощность эмиттерного перехода при $U_{EB}=1$ В, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — эмиттер при $R_{\text{св}} \leq 100$ Ом:

KT375A

KT375B

60 В

30 В

100 мА

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при $t_{\text{ш}} \leq 1$ мкс и условии, что средняя мощность за период не превышает постоянную рассеиваемую мощность коллектора

200 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T=-45...+25^\circ\text{C}$

200 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{\text{ш}} \leq 1$ мкс и условии, что средняя мощность за период не превышает постоянную рассеиваемую мощность коллектора

400 мВт

Температура р-п перехода

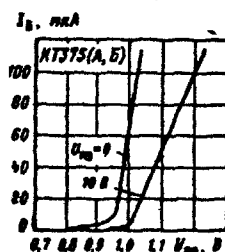
$+125^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды

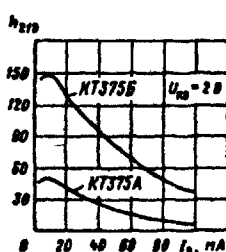
$-45...+85^\circ\text{C}$

В диапазоне температур $+25...+85^\circ\text{C}$ мощность определяется по формуле $P_{\text{К, макс}} = (125 - T)/0,5$.

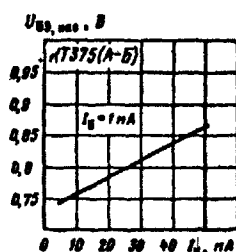
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора.



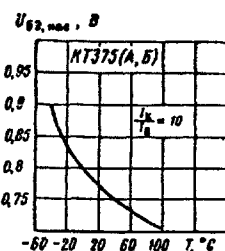
Входные характеристики



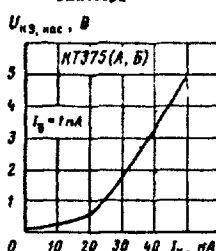
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



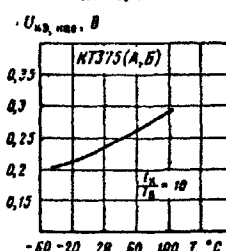
Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от температуры



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от температуры